

Title (en)

SEMICONDUCTOR CAVITY DEVICE WITH ELECTRIC LEAD.

Title (de)

HALBLEITERHOHLRAUMSCHALTUNG MIT ELEKTRISCHEM LEITER.

Title (fr)

DISPOSITIF SEMICONDUCTEUR A CAVITE AVEC UN CONDUCTEUR ELECTRIQUE.

Publication

EP 0507813 A1 19921014 (EN)

Application

EP 91901456 A 19901228

Priority

- GB 8929276 A 19891228
- GB 8929307 A 19891229

Abstract (en)

[origin: WO9110120A2] The invention provides a method of making a semiconductor cavity device provided with an electrode within its cavity and an electric lead into the cavity and electrically continuous with the electrode therewithin, comprising depositing metal, in the shape of the lead and the electrode, on a non-conductive substrate, then providing an annular insulating layer in the shape of the boundary of the cavity on the substrate including where necessary on the metal of the lead, but not of the electrode, then (preferably in vacuo) placing on the insulating layer a semiconductor formed to define the remainder of the cavity, and applying a voltage between the substrate and the semiconductor whereby to promote electrostatic bonding between the insulating layer and the semiconductor.

Abstract (fr)

Un procédé permet de produire un dispositif semiconducteur ayant une cavité avec une électrode agencée dans sa cavité et un conducteur électrique qui pénètre dans la cavité, en continuité électrique avec l'électrode contenue dans celle-ci. Selon le procédé, on dépose du métal, sous forme du conducteur et de l'électrode, sur un substrat non conducteur, puis on forme une couche isolante annulaire sur le substrat, de manière à délimiter la cavité, y compris si nécessaire sur le métal dont se compose le conducteur, mais non sur le métal dont se compose l'électrode, puis on place (de préférence sous vide) sur la couche isolante un semiconducteur qui définit le reste de la cavité et on applique une tension entre le substrat et le semiconducteur, de manière à renforcer la liaison électrostatique entre la couche isolante et le semiconducteur.

IPC 1-7

G01L 9/00

IPC 8 full level

G01L 9/00 (2006.01)

CPC (source: EP)

G01L 9/0042 (2013.01); **G01L 9/0073** (2013.01)

Citation (search report)

See references of WO 9110120A2

Designated contracting state (EPC)

AT BE CH DE DK ES FR GB GR IT LI LU NL SE

DOCDB simple family (publication)

WO 9110120 A2 19910711; **WO 9110120 A3 19910919**; EP 0507813 A1 19921014; JP H05505024 A 19930729

DOCDB simple family (application)

GB 9002035 W 19901228; EP 91901456 A 19901228; JP 50187090 A 19901228